หานิตย์ สุวรรณวงศ์ : ต้นแบบเซ็นเซอร์วัดแสงโดยใช้ผลการเปลี่ยนแปลงความด้านทาน ไฟฟ้าของผิวโลหะออกไซด์แบบเพอร์รอฟสไกท์เมื่อฉายรังสี (LIGHT SENSOR PROTOTYPE USING THE RESISTANCE CHANGE AT SURFACE OF PEROVSKITE METAL OXIDES UPON IRRADIATION) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วรวัฒน์ มีวาสนา, 77 หน้า.

อุปกรณ์เซ็นเซอร์แสงได้ใช้คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำซึ่งมีช่องว่างแถบพลังงานขนาดเล็ก ที่ไวต่อแสงในย่านที่มองเห็นแต่มีความทึบแสงภายใต้แสง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เรามีความสนใจใน การใช้สารโพแทสเซียมแทนทาเลต และสตรอนเทียมไททาเนต ซึ่งมีช่องว่างแถบพลังงานที่กว้างซึ่ง ไวต่อแสงในย่านอัลตราไวโอเลตและมีสภาพโปร่งแสง จากการศึกษาในที่นี้ พบว่าเมื่อ โพแทสเซียมแทนทาเลต และสตรอนเทียมไททาเนตถูกฉายด้วยแสงอาทิตย์ที่ถูกโฟกัสบนพื้นผิว ของสารที่อยู่ในความคันบรรยากาส จะมีการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าของสาร โดยมีค่าความ ด้านทานที่ลดลงจากค่าเริ่มต้นประมาณ 1,000 – 10,000 เท่า จากนั้นถ้าหยุดการฉายแสงความ ต้านทานจะกลับมาอยู่ในช่วงเดิมอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้แสงซินโครตรอนใน สุญญากาส พบว่าเมื่อฉายแสงทำให้ความด้านทานละกลับมาอย่างช้าๆที่ความดับต่ำ แต่เมื่อเพิ่มความคันออกซิเจนให้สูงขึ้นจะทำให้ความด้านทาน กลับคืนมาอย่างเร็วขึ้น ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงความด้านทานนี้เกี่ยวข้องกับการ หลุดออกของออกซิเจนบนพื้นผิวเมื่อมีการฉายแสงในย่านอัลตราไวโอเลต ซึ่งข้อมูลทางโครงสร้าง อิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่าออกซิเจนที่หลุดออกจะทำให้เกิดขั้นอิเล็กตรอนสองมิติบนพื้นผิวที่ ทำให้การนำไฟฟ้าดีขึ้น

จากหลักการข้างต้น นำมาใช้สร้างต้นแบบของเซ็นเซอร์แสง โดยนำผลึกเคี่ยวของ สตรอนเทียมไททาเนตที่ผ่านการทำขั้วไฟฟ้าด้วยเทคนิคการเคลือบโลหะแบบระเหย แล้วนำมาต่อ อนุกรมกับตัวต้านทานและแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม สามารถให้ค่าแสดงผลศักย์ไฟฟ้าเป็น 5 โวลต์ เมื่อมีการฉายแสงเลเซอร์ที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร แต่เมื่อหยุคฉายแสงทำให้ค่า แสดงผลศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 0 โวลต์ โดยค่าศักย์ไฟฟ้า 0 กับ 5 โวลต์นี้สามารถใช้เป็นสัญญาณปิด เปิดที่ต่อเข้ากับระบบดิจิตอลได้

สาขาวิชาฟิล	สิกส์
ปีการศึกษา	2555

ลายมือชื่อนักศึกษา	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	

SANIT SUWANWONG: LIGHT SENSOR PROTOTYPE USING THE RESISTANCE CHANGE AT SURFACE OF PEROVSKITE METAL OXIDES UPON IRRADIATION. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. WORAWAT MEEVASANA, Ph.D. 77 PP.

LIGHT SENSOR/RESISTANCE CHANGE AT SURFACE/PEROVSKITE METAL OXIDES

Most of common light sensors are made of narrow-bandgap semiconductors which are sensitive to visible light but opaque. In this work, we are interested in wider bandgap metal oxides: potassium tantalate (KTaO₃) and strontium titanate (SrTiO₃), which are sensitive to ultraviolet light and also transparent. From our study, we found that the resistances of both KTaO₃ and SrTiO₃ could decrease as much as 3-4 orders of magnitudes under exposure to focused sunlight. And, these resistances under ambient pressure would change back quickly after stopping the exposure. From additional study, we found that the resistances would also change in a similar way under exposure to synchrotron light but the recovery rate was much slower under vacuum condition. However, this recovery rate could increase largely by increasing the oxygen pressure. This finding suggests that the change in resistance occurs mostly due to the oxygen vacancy induced by the exposure to ultraviolet light. By looking at the electronic structure, it suggests that these oxygen vacancies induce two-dimensional electron gas at the surface which will make the resistance lower.

We then use the above mechanism to make light-sensor prototype. The prototype is made of SrTiO₃ crystal with electrodes made by using metal-evaporation

technique and then this sample is connected in series with a proper resistor and a battery. The voltage output of this prototype is around 5 V when the device is exposed to the light of a 405 nm laser and the voltage output is 0 V when there is no light. These outputs of 0 and 5 V can be used as digital off-on signals.



School of Physics	Student's Signature
Academic Year 2012	Advisor's Signature
	Co-advisor's Signature